

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 02121289.9

[43] 公开日 2003 年 1 月 1 日

[11] 公开号 CN 1388205A

[22] 申请日 2002.6.13 [21] 申请号 02121289.9

[71] 申请人 清华大学

地址 100084 北京市清华大学液晶大楼 4524
房间

[72] 发明人 邱 勇 乔 娟

权利要求书 2 页 说明书 17 页 附图 6 页

[54] 发明名称 一种有机电致发光材料及其应用

[57] 摘要

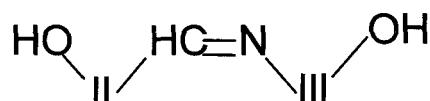
本发明涉及一种有机电致发光材料及其应用，属于电子材料技术领域。该材料是一种含有希弗碱三齿配体的金属配合物，其特征在于，该发光材料具有以下分子结构式： $(L^2L^3M)_n$ ，其中 L^2 是两齿配体， L^3 是含有希弗碱($CH=N$)结构的三齿配体， M 代表金属原子，可以是三价的金属离子，如铝、镓、铟， n 可以为 1 或者 2。本发明中的材料具有玻璃化温度高、热稳定性好，容易形成良好的无定形薄膜，在溶液和固体膜中都有较强的荧光，且荧光量子效率高等优点，本材料可优先传输电子、阻挡空穴，可用在由多层或单层有机材料组成的有机电致发光器件中的载流子传输层或发光层，也可用作掺杂的染料或者作为染料的本体材料。

- 一种有机电致发光材料，该材料是一种含有希弗碱三齿配体的金属配合物，其特征在于，该发光材料具有以下分子结构式：



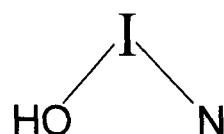
上述分子式中， L^2 是两齿配体， L^3 是含有希弗碱 ($CH=N$) 结构的三齿配体， M 代表金属原子，可以是三价的金属离子，如铝、镓、铟， n 可以为 1 或者 2。

- 根据权利要求 1 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中所述的三齿配体 L^3 具有如下结构：



上述结构式中 II, III 分别代表芳香环或者杂环化合物及其取代的衍生物，可以为苯环、萘环或菲环中的一种，或者为含有杂原子的芳香环如吡啶、噻唑或咔唑中的一种，其中 II、III 上可以有一个或多个取代基，取代基可以是氢原子、烷基、异烷基、烷氧基、硝基、氰基、氨基、卤素原子、芳香基、呋喃、噻吩、吡咯或吡啶中的一种。

- 根据权利要求 1 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中所述的 L^2 为具有两个配位原子 O, N 的两齿配体，具有如下结构式：



上述结构式中，I 代表芳香环或者杂环化合物及其取代的衍生物，其中 I 处的芳香环可以为 8—羟基喹啉、4—羟基—1, 5—萘啶、5—羟基—1—噁唑啉、2—(2—羟基苯基) 苯并噁唑、2—(2—羟基苯基) 苯并咪唑、2—(2—羟基苯基) 苯并噻唑、10—羟基苯并喹啉或吡啶—2—甲酸中的一种，其中 I 上可以有一个或多个取代基，取代基可以是氢原子、烷基、异烷基、烷氧基、硝基、氰基、氨基、卤素原子、芳香基、呋喃、噻吩、吡咯或吡啶中的一种。

- 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中所述的 I 为 8—羟基喹啉，II 和 III 均为苯环，M 为三价的金属镓离子， $n=2$ 。
- 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中 I 为 4—羟基—1, 5—萘啶，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子， n 为 1 或 2。

6. 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中 I 为 5—羟基—喹喔啉，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2。
7. 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中 I 为 2—(2—羟基苯基) 苯并噁唑及其衍生物，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2。
8. 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，I 为 2—(2—羟基苯基) 苯并咪唑及其衍生物，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2。
9. 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中所述的 I 为 2—(2—羟基苯基) 苯并噻唑及其衍生物，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2。
10. 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中 I 为 10—羟基苯并喹啉，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2。
11. 根据权利要求 1、2 或 3 所述的一种有机电致发光材料，其特征在于，其中 I 为 吡啶—2—甲酸，II、III 均为苯环，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2。
12. 权利要求 1 所述的一种有机电致发光材料的应用，其特征在于这种材料可用在由多层或单层有机材料组成的有机电致发光器件中的电子传输层或发光层，也可用作掺杂的染料或者作为染料的本体材料。
13. 根据权利要求 12 所述的一种有机电致发光材料的应用，其特征在于这种材料可用于红光染料的本体材料制备红色有机电致发光器件。

一种有机电致发光材料及其应用

技术领域：

本发明涉及一种有机电致发光材料，属于电子材料技术领域。

背景技术：

当今，随着多媒体技术的发展和信息社会的来临，对平板显示器性能的要求越来越高。近年新出现的三种显示技术：等离子显示器、场发射显示器和有机电致发光显示器（OLED），均在一定程度上弥补了阴极射线管和液晶显示器的不足。其中，OLED 具有自主发光、低电压直流驱动、全固化、视角宽、颜色丰富等一系列的优点，与液晶显示器相比，OLED 不需要背光源，视角大，功率低，其响应速度达液晶显示器的 1000 倍，其制造成本却低于同等分辨率的液晶显示器，因此，有机电致发光显示器势必具有广阔的应用前景。

OLED 的典型结构包括阴极层、阳极层，和位于这两层之间的有机功能层，有机功能层中可包括电子传输层、空穴传输层和发光层中的一种或几种功能层。相应的用于有机电致发光的材料，也可根据其在器件中所承担的功能可分为：电子传输材料、空穴传输材料和发光材料三大类。1987 年美国柯达公司的 C. W. Tang 等人采用双层结构以 8—羟基喹啉铝（Alq₃）作发光层，以芳香二胺作为空穴传输层，得到了直流低电压驱动的高亮度有机 EL 器件。这一突破性进展使有机电致发光器件成为当前发光器件研究的热点。其中 8—羟基喹啉铝兼有发光和电子传输两大功能，它的采用具有开创性的历史意义（Appl.Phys.Lett.,1987,51(913); Coordination Chemistry Reviews, 171 (1998) 161-174）。但是 Alq₃ 本身的荧光量子效率和电致发光效率还是比较低的，有机电致发光技术的发展还有赖于新型的电致发光材料的开发和器件结构的完善。

随之许许多多的 8—羟基喹啉铝的衍生物被开发出来并用于有机电致发光器件的研究中，其中大多是对其配体上作修饰以改进其性能。Y. Hamada (IEEE transactions on electron devices, 1997,44,1208) 首次创新性引入水杨醛缩亮氨酸作为三齿配体，虽然在溶液中观察到了强烈的蓝色荧光，却没有得到固体的发光材料。邵炎等人在专利 CN1258710A 中采用稳定的芳香三齿配体代替了原来的脂肪类三齿配体，得到了热稳定性和成膜性有很大提高的（水杨醛缩邻胺苯酚）—（8—羟基喹啉）合铝（III）（Al(Saph)-q）及其衍生物。在文献中也有报道（Chem. Lett.,2000,1068-1069 和 Adv. Mater. Opt. Electron., 10(6),

283-286)，采用邻羟基芳香醛缩邻羟基芳香胺作为三齿配体，取代了 Alq3 中两个 8—羟基喹啉配体，可增加分子的不对称性，从而提高的材料的成膜性能。但现有专利技术中 Al(Saph)-q 及其衍生物的中心金属离子仍然采用的是金属铝，经实验证明其产品纯化很困难。

另一类 8—羟基喹啉铝的衍生物是改换其中心金属离子，如采用 Zn、Mg、Be、Ga、In 来替换 Al，这样对配合物的发光颜色、效率和稳定性均会有一定的改变，经实验比较，其中综合性能较好的主要是中心金属离子为 Ga、Zn 和 Be 的配合物。8—羟基喹啉镓 (Gaq3) 的发光颜色为黄绿色，谱峰在 553nm 左右，具有较高的亮度。P.E.Burrowsd 等人 (.Appl.Phys.Lett. 64(20), 1994) 对比研究了 Al、Ga、In、Sc 的 8—羟基喹啉金属配合物，发现在同样的器件结构 (ITO/TPD(20nm)/Mq3(40nm)/Mg:Ag) 下，采用 Gaq3 的器件不仅表现了与 Alq3 的器件相当的外量子效率，而且具有更低的启亮电压和更高的能量效率 (比 Alq3 的器件高出 50%)。Shuit-tong Lee 等人 (J.Phys.D.34, 30-35, 2001) 对比研究了以 Al、Ga 和 In 为中心金属离子的 8—羟基喹啉金属配合物分别作为本体材料，掺杂红光染料 4-4-二氰基亚甲基-2-叔丁基-6-(1,1,7,7-四甲基-久洛尼定-9-乙烯基)-4H-吡喃 (DCJMTB)，使用 N,N' -二苯基-N,N' -双 (间甲基苯基) -1, 1'-联苯基-4, 4' -二胺 (TPD) 作为空穴传输材料的红色电致发光器件 (ITO/TPD/MQ3:DCJMTB/MQ3/Mg:Ag) 的性能，结果同样发现使用 Gaq3 作本体掺杂 DCJMTB 的器件具有饱和的红光发射，且有更高的电流效率，超过了 Alq3 作本体掺杂 DCJMTB 的器件。另外，Sapochak (J.Phys.Chem, 100, 17766-17771) 和 Andreas Elschner (Adv.Mater.23,(3),1811, 2001) 等人报道了对 2—甲基取代的 8—羟基喹啉镓的五配位化合物的研究，发现其也表现出很好的电致发光性能。由此可见，在众多试图替代 Alq3 的材料中，金属镓的配合物表现了优越的性能，被公认为是最有希望的一类材料。因此对新型的金属镓的配合物进行深入的研究是非常有意义的。

此外，以 Alq3 为代表的有机电致发光材料都属于单核的金属配合物。1992 年，S.A.Van Slyke 等人在专利 U.S Patent 5,151,629 中描述了一种氧桥键连接的 2—甲基—8—羟基喹啉铝的双核金属配合物，但由于每一个铝原子仍有一个配位点尚未饱和，所以其稳定性能远远不能达到应用的要求。1997 年 Yasunori Kijima 等人 (IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES 44(8), 1224,1997) 报道了 (2-邻羟基苯基) —苯氧氮杂茂锌 ($Zn_2(OXZ)_3Cl$) 的双核配合物，这种材料是一种较为稳定的蓝色电致发光材料。继之，2001 年 Andreas Elschner (Adv.Mater.23,(3),1811, 2001) 等人报道了对 2—甲基取代的 8—羟基喹啉镓的双核配合物的研究，发现其也表现出很好的电致发光性能。由此可见，双核金属

配合物的研究也是一个新材料开发的方向。但目前报道的用于电致发光的双核金属配合物，从结构上均属于一种两齿配体和金属离子形成的配合物。

综上所述，我们引入稳定的三齿配体，和相应的两齿配体组合开发了一系列的新型的有机电致发光金属配合物，从配位饱和和位阻效应的协同作用下，同时也产生了一系列的新型的双核金属配合物，相对于 Alq₃ 等单核配合物，其表现了不同寻常的优良性能。

发明内容：

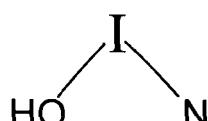
本发明的目的是提出一种新型的有机电致发光材料，该材料为金属配合物，可以改善现有技术中的以 8—羟基喹啉为配体的金属配合物和以 Al 为中心金属离子的金属配合物存在的问题，本发明目的是提高材料的荧光量子效率和电致发光效率，改善材料成膜性能，克服材料易结晶的缺点，并保证材料容易提纯。

本发明提出了一种新型的有机电致发光材料，该材料是一种含有希弗碱三齿配体的金属配合物，其特征在于，该发光材料具有以下分子结构式：



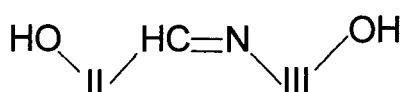
上述分子式中，L² 是两齿配体，L³ 是含有希弗碱 (CH=N) 结构的三齿配体，M 代表金属原子，可以是三价的金属离子，如铝、镓、铟，n 可以为 1 或者 2。

L² 为具有两个配位原子 O, N 的两齿配体，具有如下结构式：



其中 I 代表芳香环或者杂环化合物及其取代的衍生物，其中 I 处的芳香环可以为 8—羟基喹啉、4-羟基—1, 5—萘啶、5—羟基—喹喔啉、2—(2—羟基苯基) 苯并噁唑、2—(2—羟基苯基) 苯并咪唑、2—(2—羟基苯基) 苯并噻唑、10—羟基苯并喹啉或吡啶—2—甲酸中的一种，其中 I 上可以有一个或多个取代基，取代基可以是氢原子、烷基、异烷基、烷氧基、硝基、氰基、氨基、卤素原子、芳香基、呋喃、噻吩、吡咯或吡啶中的一种。

L³ 具有如下结构：



其中 II, III 分别代表芳香环或者杂环化合物及其取代的衍生物，可以为苯环、

萘环或菲环中的一种，或者为含有杂原子的芳香环如吡啶、噻唑或咔唑中的一种，其中 II、III 上可以有一个或多个取代基，取代基可以是氢原子、烷基、异烷基、烷氧基、硝基、氰基、氨基、卤素原子、芳香基、呋喃、噻吩、吡咯或吡啶中的一种。

根据配体 L² 结构的不同，本发明的有机电致发光材料大致可分为如下 8 类结构：

- (1) I 为 8—羟基喹啉或者取代的 8—羟基喹啉，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 为金属镓离子，铝离子或者铟离子中的一种，n 为 1 或者 2；
- (2) I 为 4—羟基—1, 5—萘啶或者取代的 4—羟基—1, 5—萘啶，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子中的一种，n 为 1 或 2；
- (3) I 为 5—羟基—1 喹喔啉或者取代 5—羟基—1 喹喔啉，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2；
- (4) I 为 2—(2—羟基苯基) 苯并噁唑及其衍生物，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2；
- (5) I 为 2—(2—羟基苯基) 苯并咪唑及其衍生物，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2；
- (6) I 为 2—(2—羟基苯基) 苯并噻唑及其衍生物，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2；
- (7) I 为 10—羟基苯并喹啉，II、III 分别为苯环、萘环或菲环中的一种，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2；
- (8) I 为 吡啶—2—甲酸，II、III 均为苯环，M 可以为镓离子、铝离子或铟离子，n 为 1 或 2。

本发明的有机电致发光材料中，优选的配合物如下表所示

合成实施例	I	II	III	M
化合物 1	8—羟基喹啉	苯基	苯基	镓
化合物 2	8—羟基喹啉	萘基	苯基	镓
化合物 3	5—氟—8—羟基喹啉	苯基	苯基	镓
化合物 4	8—羟基喹啉	苯基	苯基	铟
化合物 5	4—羟基—1, 5—萘啶	苯基	苯基	镓

化合物 6	4—羟基—1, 5—萘啶	苯基	苯基	铝
化合物 7	4—羟基—1, 5—萘啶	苯基	苯基	铟
化合物 8	5—羟基—喹喔啉	苯基	苯基	镓
化合物 9	5—羟基—喹喔啉	苯基	苯基	铝
化合物 10	5—羟基—喹喔啉	萘基	苯基	镓
化合物 11	2—(2—羟基苯基) 苯并噁唑	苯基	苯基	镓
化合物 12	2—(2—羟基苯基) 苯并噁唑	苯基	苯基	铟
化合物 13	2—(2—羟基苯基) 苯并咪唑	苯基	苯基	镓
化合物 14	2—(2—羟基苯基) 苯并咪唑	苯基	苯基	铝
化合物 15	2—(2—羟基苯基) 苯并噻唑	苯基	苯基	镓
化合物 16	2—(2—羟基苯基) 苯并噻唑	苯基	苯基	铝
化合物 17	10—羟基苯并喹啉	苯基	苯基	镓
化合物 18	10—羟基苯并喹啉	苯基	苯基	铟
化合物 19	吡啶—2—甲酸	苯基	苯基	镓
化合物 20	吡啶—2—甲酸	苯基	苯基	铝

本发明采用一种希弗碱三齿配体和两齿配体的混合配位，与三价的金属离子配位结合产生了一类新型的有机电致发光材料，尤其是为满足三价金属的饱和配位，出现了一类以化合物 1 为代表新型的双核金属配合物。中心的金属离子选用了镓、铟等半径较大金属离子替代已有技术中的金属配合物的铝离子，从而为配体的选择提供了更大的自由度，以便开发出含有更多类型的配体的金属配合物，这样进一步扩展了可用于制备有机电致发光器件的有机化合物的种类。

本发明的中的材料具有以下优点：玻璃化温度高，热稳定性好，容易形成良好的无定形薄膜，该材料在溶液和固体膜中都有较强的荧光，荧光量子效率高。

实验发现，含有三齿配体的络合物是一类稳定性极高的有机金属配合物，同时它们大多不易结晶，易于形成无定性薄膜。对于制备电致发光器件十分有力。它们拥有较高的玻璃化转变温度，其中优选的(8-羟基喹啉)-(水杨醛缩邻苯胺苯酚)合镓(III)（化合物 1）的玻璃化转变温度达到了 477K，比目前公认的最好的发光材料 Alq3 的玻璃化温度 448K 高出 30K。

本发明的有机电致发光材料可优先传输电子、阻挡空穴的，并且同时还可以用作发光体，包括单独成发光层，或者作为本体掺杂染料发光，或者作为掺杂的

染料而发光。作为发光材料，其荧光的强度的荧光量子效率是衡量其发光特性的重要指标。实验发现本发明的有机电致发光材料在溶液和固体膜状态下均有很强的荧光。其中优选的(8-羟基喹啉)-(水杨醛缩邻苯胺苯酚)合镓(III)（化合物 1）在二甲基甲酰胺溶液中的荧光量子效率为 0.318，比同样条件下的 Alq₃ 的荧光量子效率（0.116）高出了 1.74 倍。该类材料属于配体发光的金属配合物，随着配体的改变，其配合物的发光也会相应的有所移动，可以实现从绿光到红光的发射。

利用本发明的发光材料制备的有机电致发光器件可表现出高亮度、高效率的优越性能。经实验证实，无论是将本发明的材料单独作为发光层制备的有机电致发光器件，还是将本发明材料作为本体材料，掺杂染料制备的有机电致发光器件都具有很高的发光亮度和发光效率，如将本发明材料作为本体材料，掺杂如 4-4'-二氰基亚甲基-2-甲基-6-二甲氨基苯乙烯基-4H-吡喃（DCM）系列的红光染料即可实现饱和的红光发射。

附图说明：

图 1 为本发明制备的化合物 1 的质谱图。

图 2 为本发明制备的化合物 1 的单晶结构示意图。

图 3 为本发明制备的化合物 1 在 DMF 溶液中的吸收光谱（a）和荧光发射谱（b）（激发波长为 390nm）。

图 4 为利用本发明化合物 1 作电子传输和发光层制备的器件

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 1(40nm)/Mg:Ag(10:1) 的电流—电压曲线（a）和亮度—电压曲线（b）。

图 5 为利用本发明化合物 1 制备的器件

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 1(40nm)/Mg:Ag(10:1) 的电致发光光谱图。

图 6 为利用本发明化合物 1 制备的红光器件

ITO/NPB(30nm)/ 化合物 1: DCJTB(2%， 40nm)/ 化合物 1 (15nm) /Mg:Ag(10:1) 的电致发光光谱。

图 7 为利用本发明化合物 1 制备的红光器件

ITO/NPB(30nm)/ 化合物 1: DCJTB(2%， 40nm)/ 化合物 1 (15nm) /Mg:Ag(10:1) 的亮度—电流—电压曲线。

具体实施方式：

以下介绍本发明的实施方式。

化合物样品制备的实施方式：

本发明的有机电致发光材料，采用在有机溶剂中合成的方法制备。采用的步骤包括两部分：一是相应的三齿配体的合成，二是目标配合物的合成。

其中第一步的相关的三齿配体的合成采用希弗碱（Schiff base）的合成方法。具体过程是将含有计量比的邻羟基的芳香醛与含有邻羟基的芳香胺固相直接混合加热反应，或者在醇溶剂中加热回流反应，均可得到相应希弗碱的粗产品。然后通过在有机溶剂中重结晶的方法，很容易得到纯度很高的产品。

第二步的目标化合物的合成采用三价金属（如镓、铝、铟）的无机盐和相应的配体在醇和水的体系中，通过加入碱控制产物的生成。粗产品经过分区升华的方法提纯即可得高纯得产品。

实施例 1：化合物 1 的合成

配体水杨醛缩邻氨基苯酚的合成：

称取水杨醛 1.22 克（0.01 摩尔）放入反应瓶，加入等摩尔的邻氨基苯酚 1.09 克（0.01 摩尔），直接加热，即有红色物质产生，等反应完成后，使用乙醇重结晶即可得到针状的产品，即水杨醛缩邻氨基苯酚，产率为 85%。

化合物 1 的合成：

在装有搅拌装置的三口烧瓶中，加入 20 毫升 0.88 克（0.005 摩尔）无水三氯化镓的乙醇溶液。将 0.73 克(0.005 摩尔)8—羟基喹啉完全溶解于 20ml 乙醇和 0.43 克（0.005 摩尔）六氢吡啶的混合溶液，将此溶液在搅拌下慢慢滴入上述的溶液中，加完后继续搅拌 5 分钟。将 1.065 克（0.005 摩尔）水杨醛缩邻氨基苯酚完全溶解于 100ml 乙醇和 0.85 克（0.01 摩尔）六氢吡啶的混合溶液，将此溶液在搅拌下慢慢滴加入上述的反应溶液中，加完后继续搅拌 1 个小时，然后与暗处放置陈化。最后将此溶液加入与其等体积的去离子水，立即有大量的絮状沉淀产生，放入冰箱陈化 10 个小时，抽滤出固体，红外灯下干燥即得粗产品，产率为 85%。再经过分区升华提纯得到橙黄色的固体，即(8-羟基喹啉)-(水杨醛缩邻氨基苯酚)合镓(III)(化合物 1)纯品。

元素分析结果是：C 62.28%，H 3.52%，N 6.52%，O 11.53%；与理论值 C 62.13%，H 3.51%，N 6.52%，O 11.53% 吻合很好。质谱测定分子量为 $M^+=850$ ，参见附图 1。从分区升华提纯的样品中挑选得到的单晶，经单晶 X 射线衍射分析结果

表明其为一个双核的金属镓的混配络合物，参见附图 2。另外将其配制成 10—5mol/L 的 DMF 溶液，测定紫外可见吸收和荧光发射光谱，请参见附图 4。DSC 测试可得其玻璃化转变温度为 204°C。

实施例 2：化合物 2 的合成

按照化合物 1 的方法合成，其中的三齿配体采用配体 2—羟基—1—萘甲醛缩邻氨基苯酚的合成即可。质谱：m/e, 950, 475；元素分析：实验测定 C: 65.60%，H: 3.49% N: 5.80%；理论值：C: 65.68%，H: 3.58%，N: 5.89%

实施例 3：化合物 3 的合成

按照化合物 1 的方法合成，采用 5—氟—8—羟基喹啉替换 8—羟基喹啉即可。质谱：m/e, 886, 443；元素分析：实验测定 C: 59.52, H: 4.32, N: 6.30；理论值：C: 59.59, H: 4.29, N: 6.32。

实施例 4：化合物 4 的合成

按照化合物 1 的方法合成，采用氯化铟替代氯化镓即可。质谱：m/e, 940, 470；元素分析：实验测定 C: 56.10, H: 3.15, N: 5.89；理论值：C: 56.17, H: 3.19, N: 5.96

实施例 5：化合物 5 的合成

按照化合物 1 的方法合成，采用 4—羟基—1,5—萘啶替换 8—羟基喹啉即可。质谱：m/e, 852, 426；元素分析：实验测定 C: 59.10, H: 3.20, N: 9.81；理论值：C: 59.15, H: 3.29, N: 9.86。

实施例 6：化合物 6 的合成。

按照化合物 1 的方法合成，采用 4—羟基—1,5—萘啶替换 8—羟基喹啉，氯化铝替代氯化镓即可。质谱：m/e, 766, 383；元素分析：实验测定 C: 65.89, H: 3.56, N: 11.09；理论值：C: 65.80, H: 3.66, N: 10.97。

实施例 7：化合物 7 的合成

按照化合物 1 的方法合成，采用 4—羟基—1,5—萘啶替换 8—羟基喹啉，氯化铟替代氯化镓即可。质谱：m/e, 942, 471；元素分析：实验测定 C: 53.42, H: 2.86, N: 9.05；理论值：C: 53.50, H: 2.97, N: 8.92。

实施例 8：化合物 8 的合成

按照化合物 1 的方法合成，采用 5—羟基—喹喔啉替换 8—羟基喹啉即可。质

谱: m/e, 852, 426; 元素分析: 实验测定 C: 59.10, H: 3.20, N: 9.81; 理论值: C: 59.15, H: 3.29, N: 9.86。

实施例 9: 化合物 9 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 5-羟基-1-唑啉替换 8-羟基喹啉, 氯化铝替代氯化镓即可。质谱: m/e, 766, 383; 元素分析: 实验测定 C: 65.89, H: 3.56, N: 11.09; 理论值: C: 65.80, H: 3.66, N: 10.97

实施例 10: 化合物 10 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 5-羟基-1-唑啉替换 8-羟基喹啉, 其中的三齿配体采用 2-羟基-1-萘甲醛缩邻羟基苯胺即可。质谱: m/e, 952, 476; 元素分析: 实验测定 C: 63.00, H: 3.33, N: 8.75; 理论值: C: 63.03, H: 3.36, N: 8.82。

实施例 11: 化合物 11 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 2-(2-羟基苯基)苯并噁唑替换 8-羟基喹啉即可。质谱: m/e, 982, 491; 元素分析: 实验测定 C: 63.39, H: 3.40, N: 5.62; 理论值: C: 63.41, H: 3.46, N: 5.69。

实施例 12: 化合物 12 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 2-(2-羟基苯基)苯并噁唑替换 8-羟基喹啉, 氯化铝替代氯化镓即可。质谱: m/e, 896, 448; 元素分析: 实验测定 C: 69.80, H: 3.69, N: 6.35; 理论值: C: 69.64, H: 3.79, N: 6.25。

实施例 13: 化合物 13 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 2-(2-羟基苯基)苯并咪唑替换 8-羟基喹啉即可。质谱: m/e, 980, 490; 元素分析: 实验测定 C: 63.65, H: 3.65, N: 8.52; 理论值: C: 63.67, H: 3.67, N: 8.57。

实施例 14: 化合物 14 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 2-(2-羟基苯基)苯并咪唑替换 8-羟基喹啉, 氯化铝替代氯化镓即可。质谱: m/e, 894, 447; 元素分析: 实验测定 C: 69.75, H: 3.90, N: 9.25; 理论值: C: 69.80, H: 4.03, N: 9.40。

实施例 15: 化合物 15 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 2-(2-羟基-苯基)苯并噁唑替换 8-羟基喹啉

即可。质谱: m/e, 1014, 507; 元素分析: 实验测定 C: 61.50, H: 3.36, N: 5.50; 理论值: C: 61.54, H: 3.35, N: 5.52。

实施例 16: 化合物 16 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 2-(2-羟基-苯基)苯并噻唑替换 8-羟基喹啉, 氯化铝替代氯化镓即可。质谱: m/e, 928, 464; 元素分析: 实验测定 C: 67.35, H: 3.49, N: 5.88; 理论值: C: 67.24, H: 3.66, N: 6.03

实施例 17: 化合物 17 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 10-羟基苯并喹啉替换 8-羟基喹啉。质谱: m/e, 475; 元素分析: 实验测定 C: 65.67, H: 3.55, N: 5.87; 理论值: C: 65.68, H: 3.58, N: 5.89。

实施例 18: 化合物 18 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 10-羟基苯并喹啉替换 8-羟基喹啉, 氯化铟替代氯化镓即可。质谱: m/e, 1040, 520; 元素分析: 实验测定 C: 60.25, H: 3.57, N: 5.26; 理论值: C: 60.00, H: 3.27, N: 5.38。

实施例 19: 化合物 19 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 吡啶-2-甲酸替换 8-羟基喹啉即可。质谱: m/e, 806, 403; 元素分析: 实验测定 C: 56.69, H: 3.16, N: 6.79; 理论值: C: 56.58, H: 3.23, N: 6.95。

实施例 20: 化合物 20 的合成

按照化合物 1 的方法合成, 采用 吡啶-2-甲酸替换 8-羟基喹啉, 氯化铝替代氯化镓即可。质谱: m/e, 720, 360; 元素分析: 实验测定 C: 63.25, H: 3.45, N: 7.85; 理论值: C: 63.33, H: 3.61, N: 7.78。

有机电致发光器件实施例:

实施例 21: 采用化合物 1 单独作发光和电子传输材料, 制备了有机电致发光器件, 其结构为: ITO/NPB(40nm)/ 化合物 1 (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟-二氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上, 通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N-苯基-1-萘胺)-联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光材料本发明中的化合物 1 ((8-羟基喹啉)-(水杨醛缩邻苯胺苯酚)合镓(III)) 和 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金

作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 2.5V，最大发光波长为 578nm，最大亮度为 4400cd/m²（电压为 25 V 时）。其电流—电压曲线和亮度—电压曲线请参见附图 4，电致发光光谱参见附图 5。

实施例 22：采用化合物 1 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了四种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 1: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag (红色器件 1);

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 1: DCJTB(2%)(30nm)/化合物 1(30nm)/Mg:Ag (红色器件 2);

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 1: DCJTB(2%)(40nm)/ 化合物 1(20nm)/Mg:Ag (红色器件 3)。

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 1: DCJTB(2%)(40nm)/ 化合物 1(15nm)/Mg:Ag (红色器件 4)。

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二(N—苯基—1—萘胺) —联苯二胺 (NPB)，30nm 的发光层为本发明中的化合物 1 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB，然后再分别蒸镀化合物 1 (0, 30, 20, 15nm 分别对应红色器件 1, 2, 3 和 4) 和 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。红色器件 4 的电流—电压曲线和亮度—电压曲线请参见附图 7，电致发光光谱参见附图 6。

这四种红色电致发光器件的性能测试结果如下表：

器件	启亮电压/V	最大亮度(cd/m ²)	发光波长/nm	色坐标(x,y)
红色器件 1	2.5	2980(24V)	644	0.67,0.33
红色器件 2	3	6690(20V)	644	0.66,0.34
红色器件 3	2.5	7260(20V)	644	0.67,0.33
红色器件 4	2.2	9190(21V)	632	0.65,0.35

不论是作电子传输和发光材料，还是作染料尤其是红光染料的本体材料，本发明的化合物 1 表现了很好的性能，尤其是作为红光染料的本体材料，相对于经典的 Alq₃ 红光染料掺杂器件，不论是启亮电压和亮度上，还是红光发光的色纯度上，均表现了优越的性能。

实施例 23：采用化合物 2 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红

色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 2: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟一氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N-苯基-1-萘胺) - 联苯二胺 (NPB)，40nm 的发光层为本发明中的化合物 2 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.0V，最大发光波长为 645nm，最大亮度为 2560cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 24：采用化合物 3 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 3: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟一氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N-苯基-1-萘胺) - 联苯二胺 (NPB)，40nm 的发光层为本发明中的化合物 3 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 2.6V，最大发光波长为 640nm，最大亮度为 3500cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 25：采用化合物 4 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 4: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟一氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N-苯基-1-萘胺) - 联苯二胺 (NPB)，40nm 的发光层为本发明中的化合物 4 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.2V，最大发光波长为 650nm，最大亮度为 2400cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 26：采用化合物 5 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 5: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟一氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发

的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N—苯基-1—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 5 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下: 启亮电压为 3.0V, 最大发光波长为 636nm, 最大亮度为 3650cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 27: 采用化合物 6 作本体材料, 摻杂红光染料如 DCJTB, 制备了一种红色电致发光器件, 其器件结构:

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 6: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上, 通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N—苯基-1—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 6 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下: 启亮电压为 3.0V, 最大发光波长为 632nm, 最大亮度为 3460cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 28: 采用化合物 7 作本体材料, 摻杂红光染料如 DCJTB, 制备了一种红色电致发光器件, 其器件结构:

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 7: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上, 通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N—苯基-1—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 7 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下: 启亮电压为 3.5V, 最大发光波长为 640nm, 最大亮度为 2850cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 29: 采用化合物 8 作本体材料, 摻杂红光染料如 DCJTB, 制备了一种红色电致发光器件, 其器件结构:

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 8: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上, 通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N—苯基-1—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 8 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下: 启亮电压为 3.0V, 最大发光波长为

635nm，最大亮度为 $2950\text{cd}/\text{m}^2$ （电压为 25 V 时）。

实施例 30：采用化合物 9 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 9: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟一氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N-苯基-1-萘胺) - 联苯二胺 (NPB)，40nm 的发光层为本发明中的化合物 9 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 634nm，最大亮度为 $2670\text{cd}/\text{m}^2$ （电压为 25 V 时）。

实施例 31：采用化合物 10 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 10: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟一氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N-苯基-1-萘胺) - 联苯二胺 (NPB)，40nm 的发光层为本发明中的化合物 10 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.2V，最大发光波长为 638nm，最大亮度为 $2840\text{cd}/\text{m}^2$ （电压为 25 V 时）。

实施例 32：采用化合物 11 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 11: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟一氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基-N,N'-二(N-苯基-1-萘胺) - 联苯二胺 (NPB)，40nm 的发光层为本发明中的化合物 11 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 630nm，最大亮度为 $2560\text{cd}/\text{m}^2$ （电压为 25 V 时）。

实施例 33：采用化合物 12 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 12: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二（N—苯基—1—萘胺）—联苯二胺（NPB），40nm 的发光层为本发明中的化合物 12 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.0V，最大发光波长为 632nm，最大亮度为 2235cd/m²（电压为 25 V 时）。

实施例 34: 采用化合物 13 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 13: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二（N—苯基—1—萘胺）—联苯二胺（NPB），40nm 的发光层为本发明中的化合物 13 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.2V，最大发光波长为 628nm，最大亮度为 2790cd/m²（电压为 25 V 时）。

实施例 35: 采用化合物 14 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 14: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二（N—苯基—1—萘胺）—联苯二胺（NPB），40nm 的发光层为本发明中的化合物 14 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 630nm，最大亮度为 2655cd/m²（电压为 25 V 时）。

实施例 36: 采用化合物 15 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 15: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二（N—苯基—1

—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 15 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 632nm，最大亮度为 2567cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 37：采用化合物 16 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 16: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二(N—苯基—1—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 16 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.4V，最大发光波长为 626nm，最大亮度为 2455cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 38：采用化合物 17 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 17: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二(N—苯基—1—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 17 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 630nm，最大亮度为 2046cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 39：采用化合物 18 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 18: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡 (ITO) 覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二(N—苯基—1—萘胺) —联苯二胺 (NPB), 40nm 的发光层为本发明中的化合物 18 和 2% (质量百分比) 的红光染料 DCJTB, 然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 625nm，最大亮度为 1867cd/m² (电压为 25 V 时)。

实施例 40：采用化合物 19 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 19: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二（N—苯基—1—萘胺）—联苯二胺（NPB），40nm 的发光层为本发明中的化合物 19 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 628nm，最大亮度为 1985cd/m²（电压为 25 V 时）。

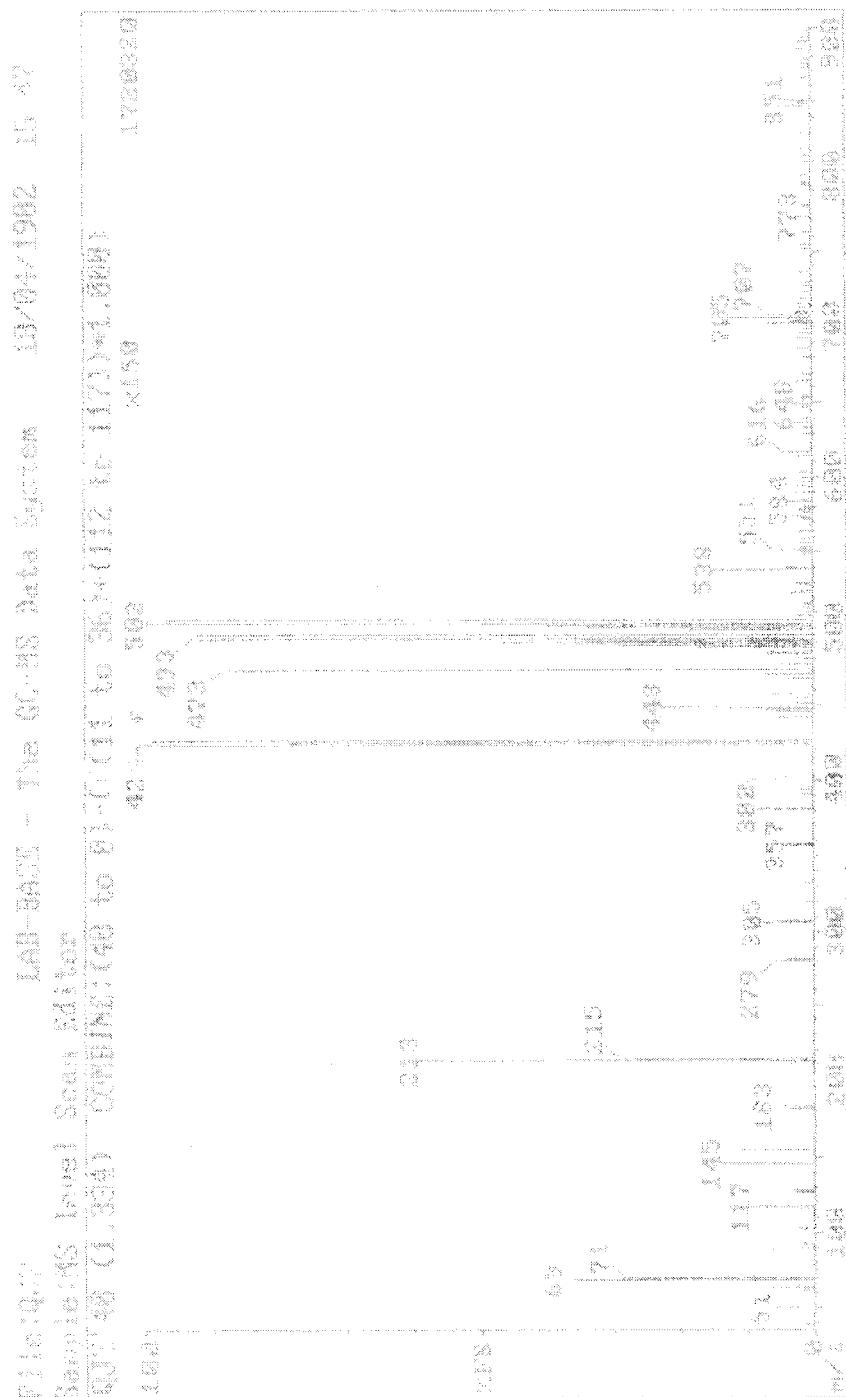
实施例 41：采用化合物 20 作本体材料，掺杂红光染料如 DCJTB，制备了一种红色电致发光器件，其器件结构：

ITO/NPB(40nm)/ 化合物 20: DCJTB (2%) (40nm)/Mg:Ag

在一个清洁过的氧化铟—氧化锡（ITO）覆盖的玻璃基片上，通过真空蒸发的方法依次连续蒸镀 40nm 的空穴传输材料 N,N'-二苯基—N,N'-二（N—苯基—1—萘胺）—联苯二胺（NPB），40nm 的发光层为本发明中的化合物 20 和 2%（质量百分比）的红光染料 DCJTB，然后再蒸镀 200nm 的金属 Mg: Ag (10: 1) 的合金作阴极。该器件的性能测试结果如下：启亮电压为 3.5V，最大发光波长为 626nm，最大亮度为 1850cd/m²（电压为 25 V 时）。

作为红光染料的本体材料，化合物 2—20 均表现了很好的性能，上述器件结构再经优化会有更好的表现。

尽管结合优选实施例对本发明进行了说明，但本发明并不局限于上述实施例，应当理解，所附权利要求概括了本发明的范围，在本发明构思的引导下，本领域的技术人员应意识到，对本发明的各实施例方案所进行的一定的改变，都将被本发明的权利要求书的精神和范围所覆盖。



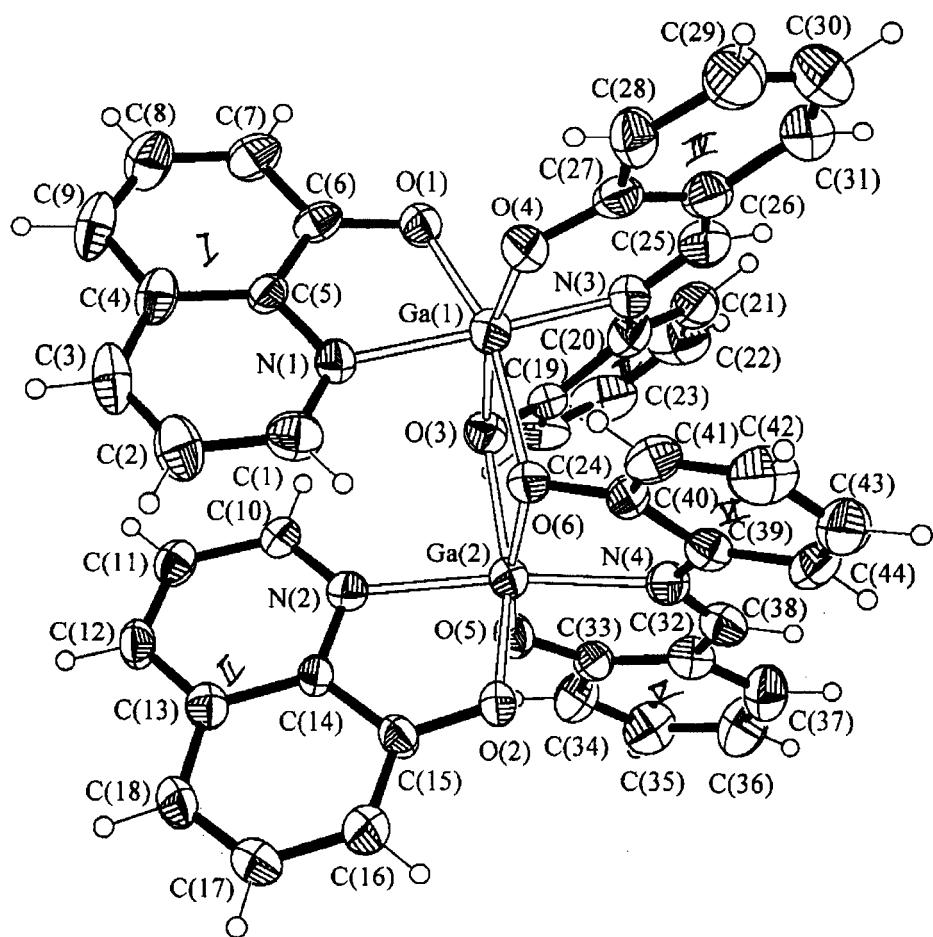
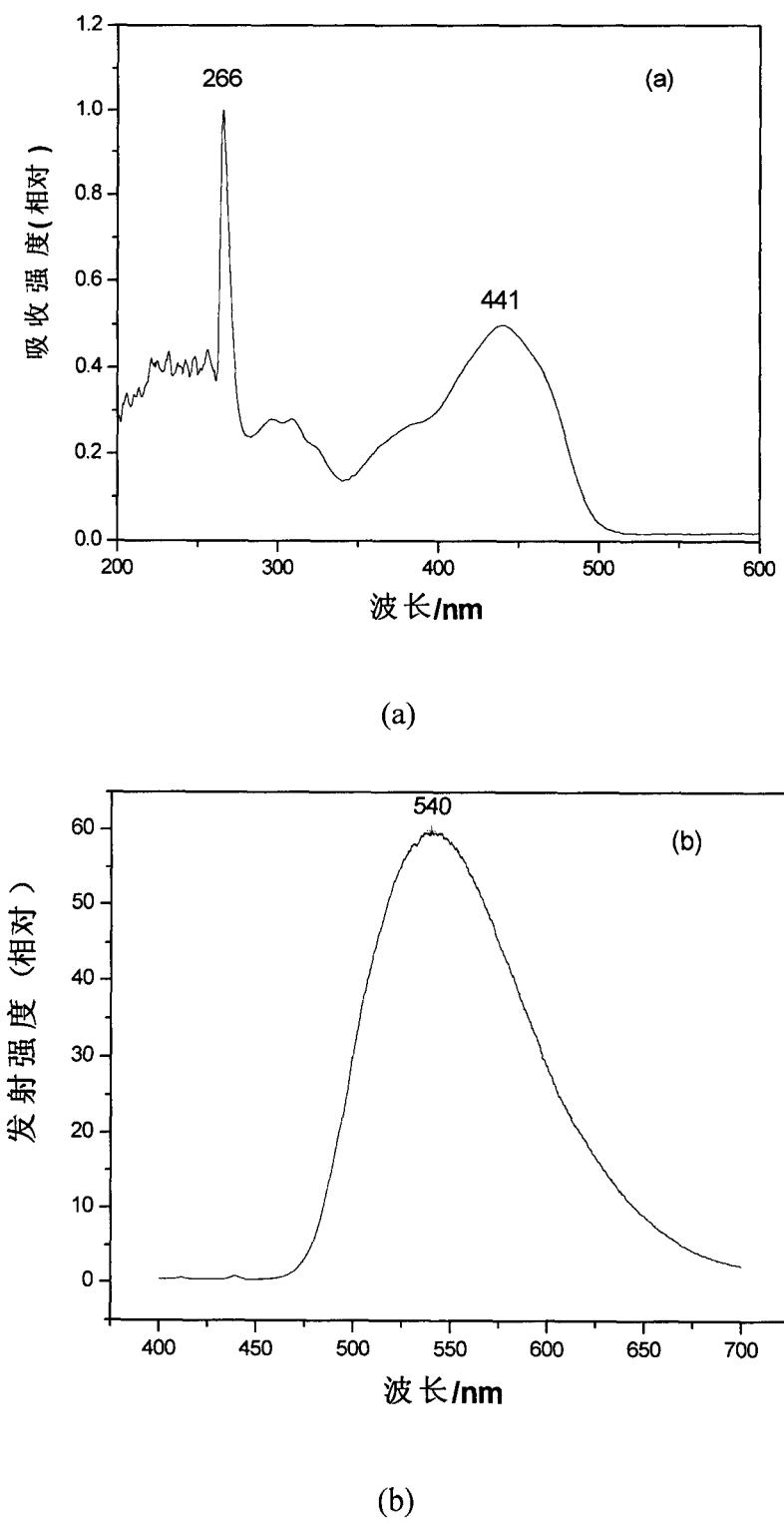


图 2



(b)

图 3

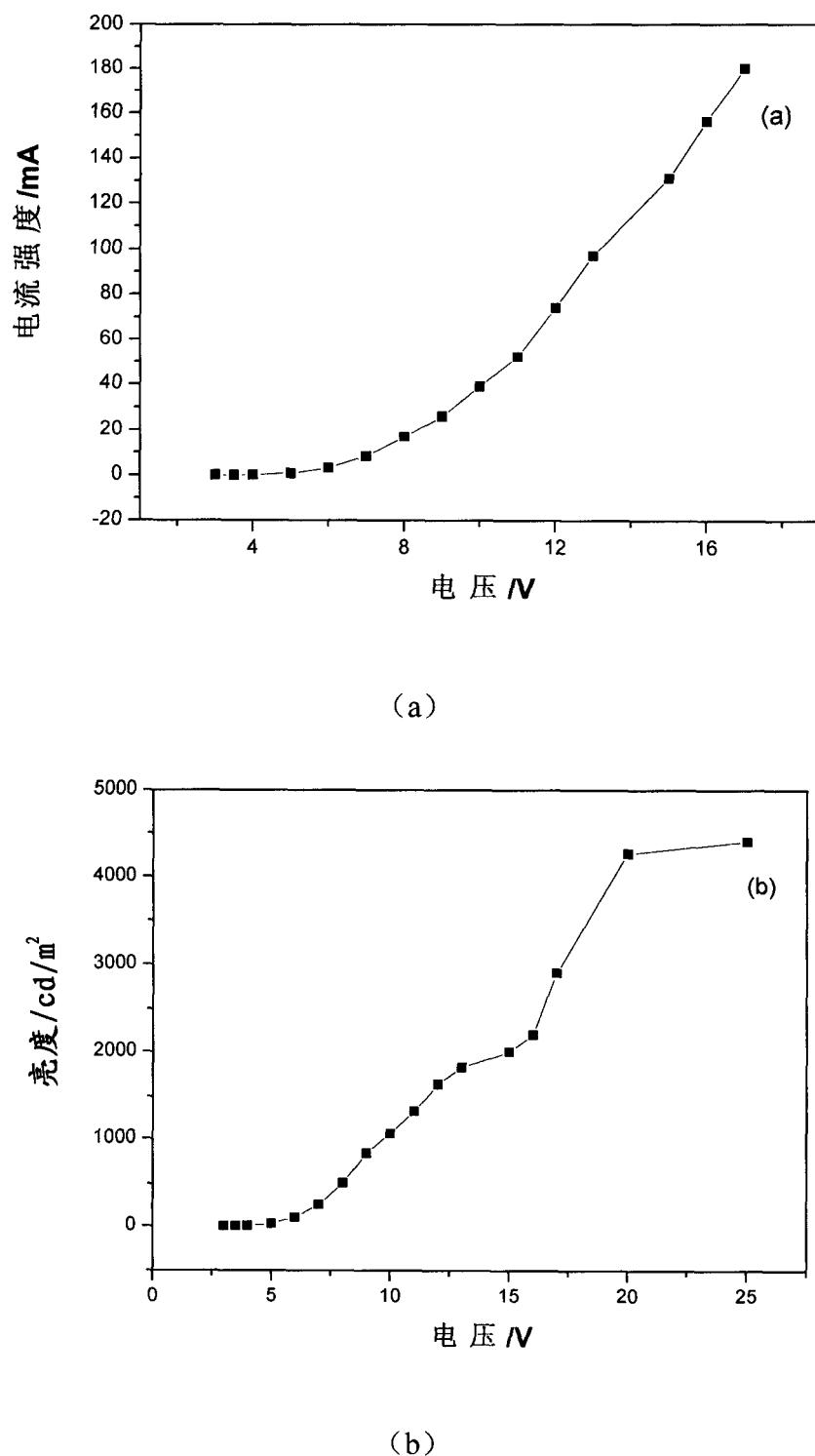


图 4

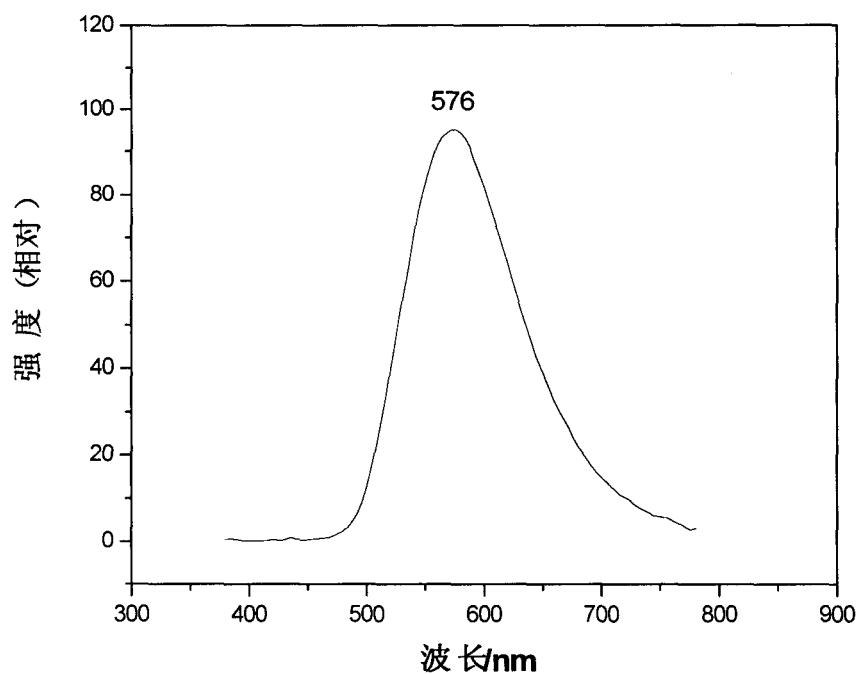


图 5

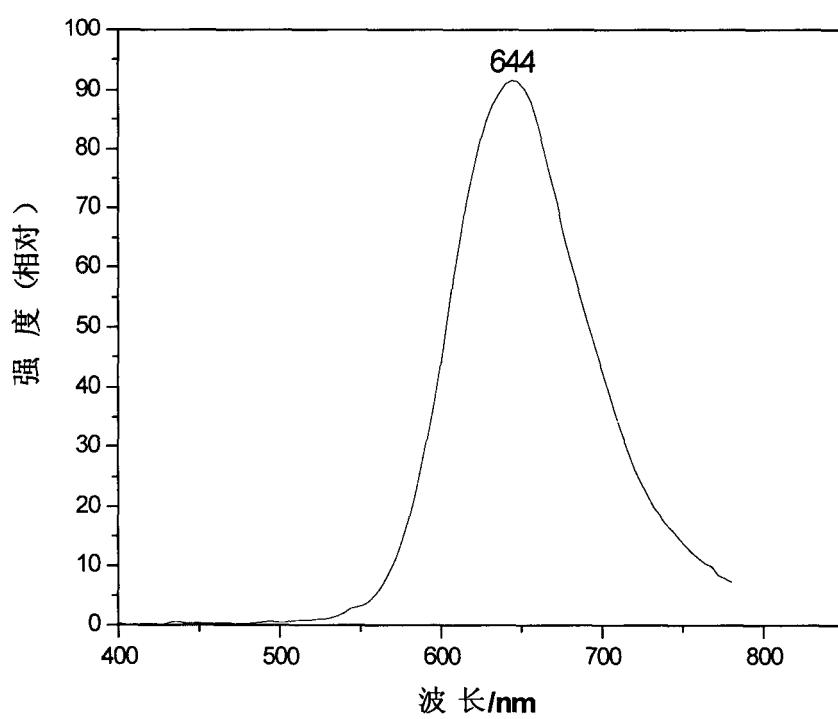


图 6

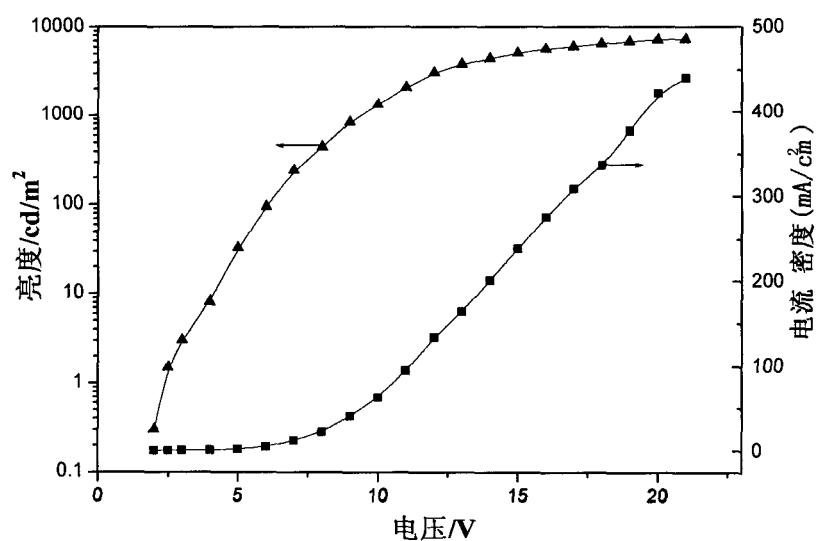


图 7

专利名称(译)	一种有机电致发光材料及其应用		
公开(公告)号	CN1388205A	公开(公告)日	2003-01-01
申请号	CN02121289.9	申请日	2002-06-13
[标]申请(专利权)人(译)	清华大学		
申请(专利权)人(译)	清华大学		
当前申请(专利权)人(译)	清华大学		
[标]发明人	邱勇 乔娟		
发明人	邱勇 乔娟		
IPC分类号	C09K11/06		
其他公开文献	CN1250674C		
外部链接	Espacenet Sipo		

摘要(译)

本发明涉及一种有机电致发光材料及其应用,属于电子材料技术领域。该材料是一种含有希弗碱三齿配体的金属配合物,其特征在于,该发光材料具有以下分子结构式:(L2L3M)_n,其中L2是两齿配体,L3是含有希弗碱(CH=N)结构的三齿配体,M代表金属原子,可以是三价的金属离子,如铝、镓、铟,n可以为1或者2。本发明中的材料具有玻璃化温度高、热稳定性好,容易形成良好的无定形薄膜,在溶液和固体膜中都有较强的荧光,且荧光量子效率高等优点,本材料可优先传输电子、阻挡空穴,可用在由多层或单层有机材料组成的有机电致发光器件中的载流子传输层或发光层,也可用作掺杂的染料或者作为染料的本体材料。

